小结: 常见半导体的晶体结构

IV族单质: C(金刚石)、 IV、III-V、II-VI族化合物: IV、III-V、II-VI族化合物: Si、Ge SiC、GaAs、InSb、ZnS等 SiC、GaN、ZnO、ZnS等

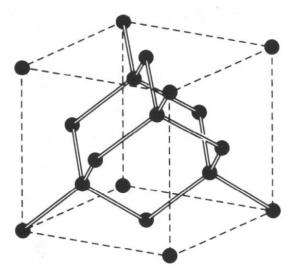


图 23 金刚石型晶体结构。图中显 示了四面体键合的排列方式。

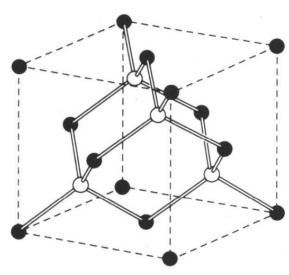


图 24 立方硫化锌的晶体结构。

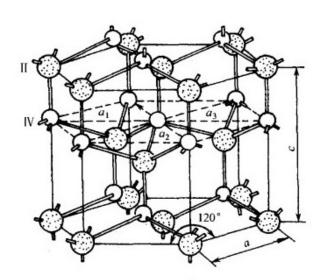


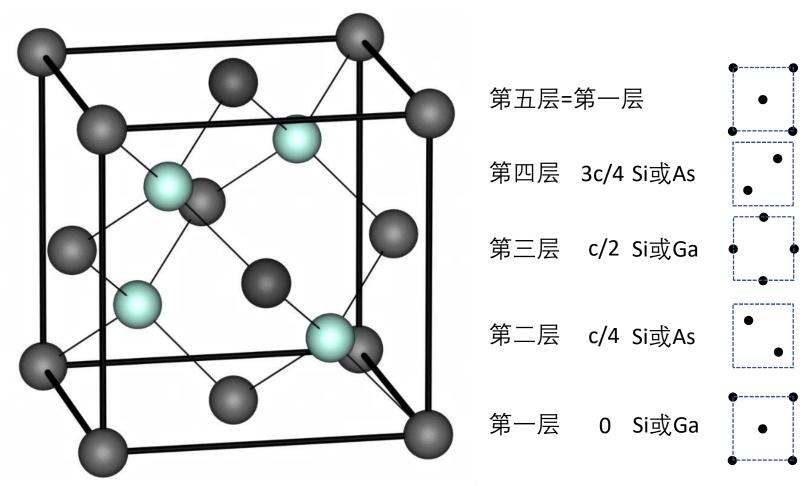
图 1-3 纤锌矿型结构

金刚石结构 非极性共价键 立方闪锌矿结构 弱极性共价键

六方纤锌矿结构 强极性共价键

小结: 金刚石/闪锌矿晶体结构

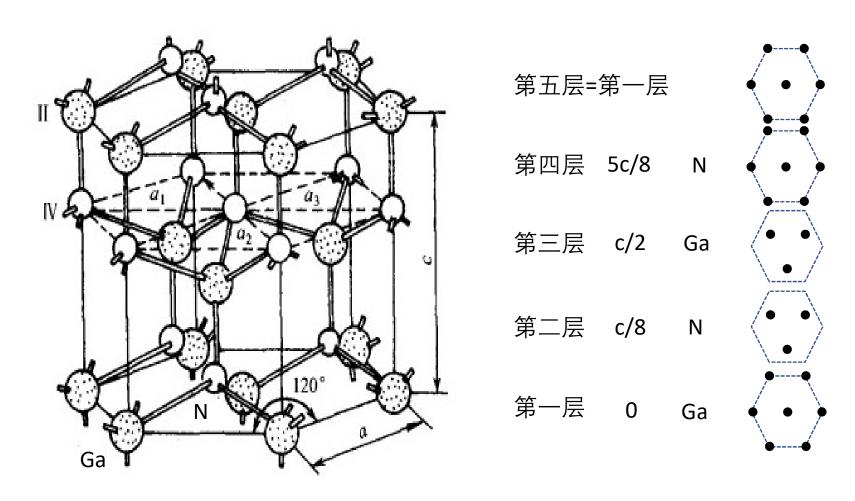
例: Si或GaAs



小结: 金刚石/闪锌矿晶体结构

- 晶胞: 金刚石/立方闪锌矿AB结构
 - 正四面体配位, 非极性/弱极性共价键
 - 每个晶胞含8个原子/A、B原子各4个
- 晶格: 立方晶格
- 晶格常数: a = b = c , $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
- 原胞: 2个相邻原子/1A+1B (可多种方式选择)
- 原胞晶格: 面心立方晶格

纤锌矿晶体结构



注意: 层间的间距不是均匀的

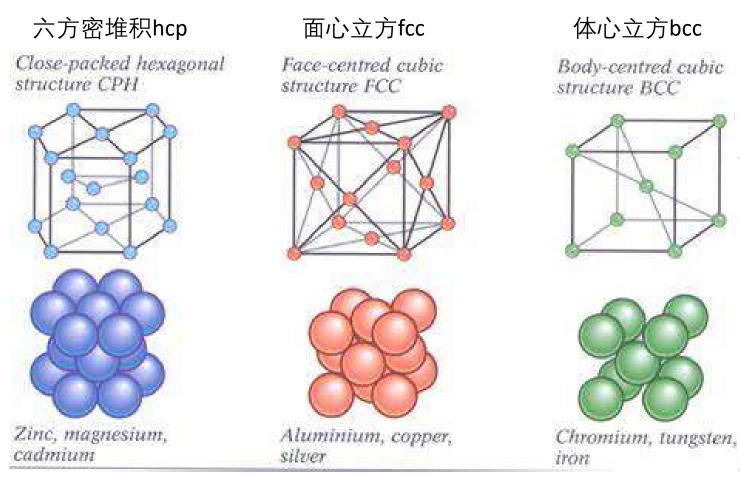
小结: 纤锌矿晶体结构

- 晶胞: 六方纤锌矿AB结构
 - 正四面体配位, 强极性共价键
 - •每个晶胞含A、B原子各6个
- 晶格: 六方晶格
- 晶格常数: a = b, $c = \sqrt{8/3} a$, $\alpha = \beta = 90^{\circ}$, $\gamma = 120^{\circ}$
- 原胞: 1A + 1B (可多种方式选择)
- 原胞晶格: 六方密堆积晶格

固体的结构

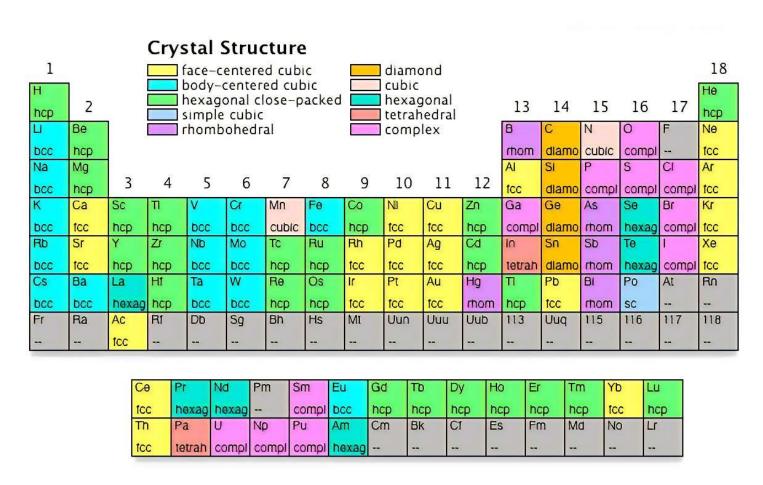
- 不局限于半导体材料,微电子产业中所用到的固体材料都可分类为单晶、多晶、非晶
 - 导体(metal)、绝缘体/电介质(insulator/dielectric)以多晶和非晶为主
 - 导体如铜Cu、铝AI、钨W、钛Ti、氮化钛TiN、氮化钽 TaN等
 - 绝缘体如氧化硅SiO₂、氧化铝Al₂O₃、氧化钽Ta₂O₅、 氧化锆ZrO₂、氧化铪HfO₂、氮化硅Si₃N₄等
- 需要用到相应晶体结构时可查询Springer Materials等数据库

例: 金属的晶体结构



Ti Cu、Al W

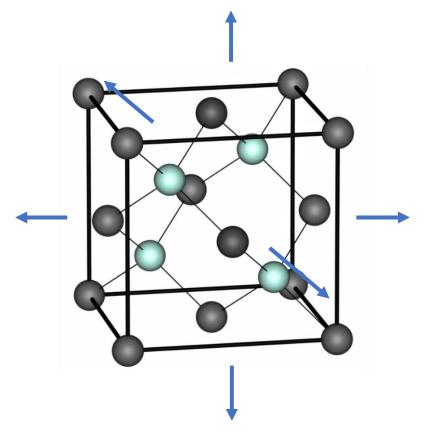
例: 金属的晶体结构



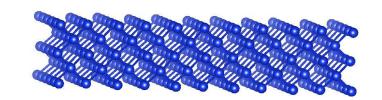
晶体的截断与晶面

理想晶体: 向三个方向无限伸展

实际晶体:在某个面上会截断 这种面称为<u>晶面</u>(crystal plane)



例如: 在x、y方向有5个晶胞, z方 向有1个晶胞



还可以斜着截断

也可以假想截断, 也称为晶面

晶面指数 (密勒指数)

截面和晶胞的三个轴的截距的倒数,约分到最小整数,称为<u>晶面指数</u> 又称为密勒指数(Miller index)

用圆括号括起来: (hkl)或(HKL)

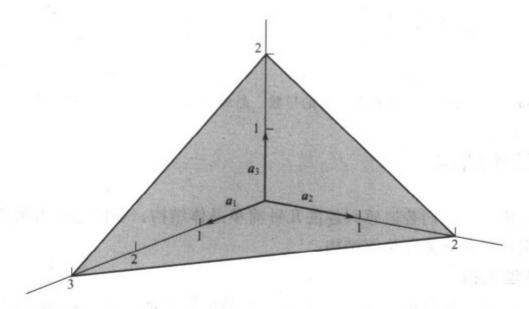


图 13 图中所示平面在 a_1 、 a_2 和 a_3 三个轴上的截距分别为 $3a_1$ 、 $2a_2$ 和 $2a_3$,其系数的倒数为 1/3、1/2、1/2。与之具有同样比率的三个最小整数是 2、3、3。因而,该面的指数为 (233)。

常见的晶面

常用的晶面为(100)、(110)、(111)三类

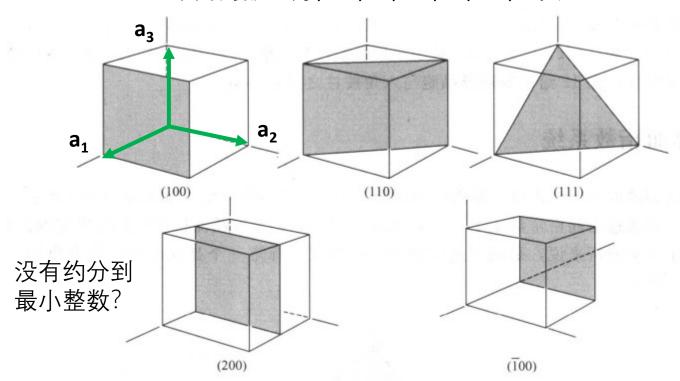


图 14 立方晶体中一些重要晶面的指数。晶面 (200) 平行于 (100) 和 (100)。

截距为无穷大,指数为0;截距为负向,指数为负,可在前面或上面加负号对称性相同的晶面可统一用花括号表示,如在立方晶体中,{100}为(100)、(010)、(001)等的总称。每种有多少个?

晶面命名的传统

- 第一种: 只关注面的取向, 不关心位置
 - 截面和晶胞的三个轴的截距的倒数,<u>约分到最小整数</u>, 作为晶面指数
 - 教材上这样讲的多一点
- 第二种: 既关注面的取向, 也关心位置
 - 截面和晶胞的三个轴的截距的倒数,<u>不约分</u>,作为<u>晶</u> <u>面指数</u>
 - 通常此时所关心的面都在晶胞之内
 - 科研中用得略多一点
 - 原点和晶面(hkl)的距离称为<u>晶面间距</u>

晶向

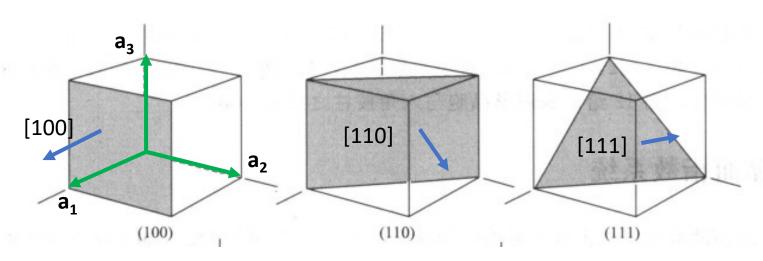
任意一个方向按照晶胞的三个正格矢分解,约分到最小整数,称为<u>晶向</u> (crystal orientation)

用方括号括起来[hkl]或[HKL]

晶向通常都会约分

晶向方向为 $ha_1+ka_2+la_3$

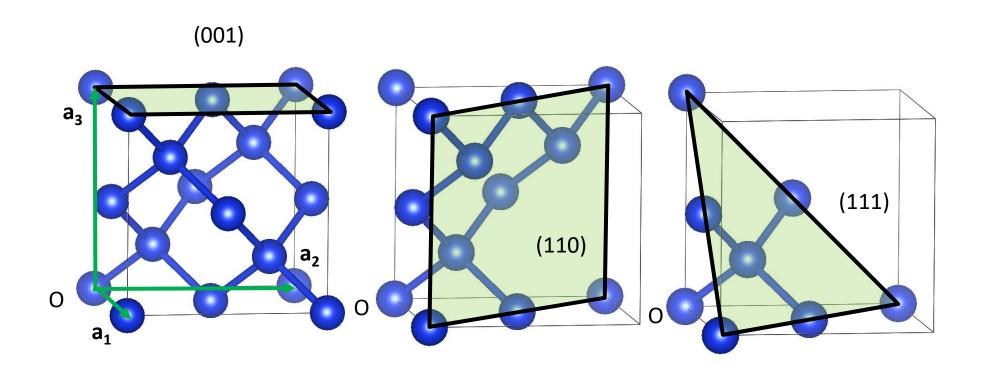
在立方晶系中,晶向[hkl]和晶面(hkl)垂直



晶向为负时, 可在数字前面或上面加负号

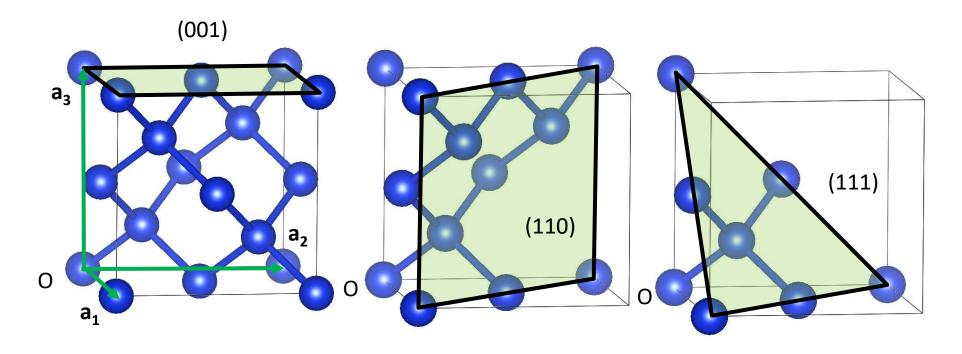
对称性相同的晶向可统一用尖括号表示,如在立方晶体中, <100>为[100]、[010]、 [001]等的总称

硅的常见晶面



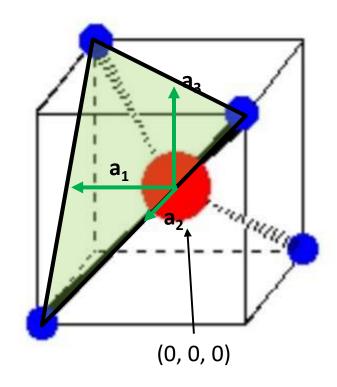
硅的晶面间距

- 定义为:原点和晶面(hkl)的距离
- 硅的晶面间距怎么计算?

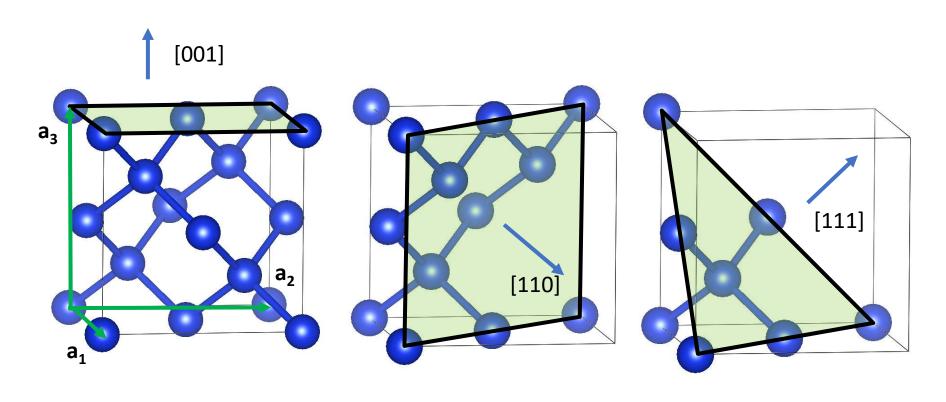


正四面体配位和晶面

- 中心原子置于原点,正格矢定为半个立方体边长
- 正四面体的每个面是什么晶面?



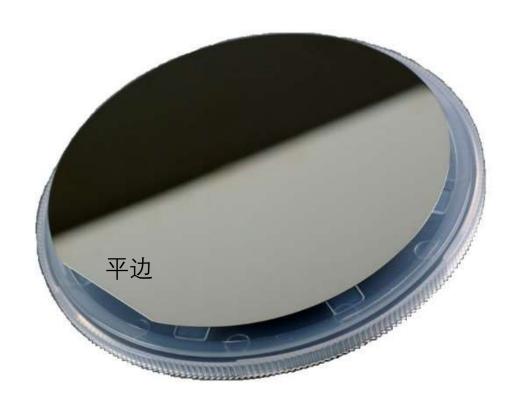
硅的常见晶向



怎样判定两个晶向之间的相对位置关系(如垂直)?

硅晶圆的晶向

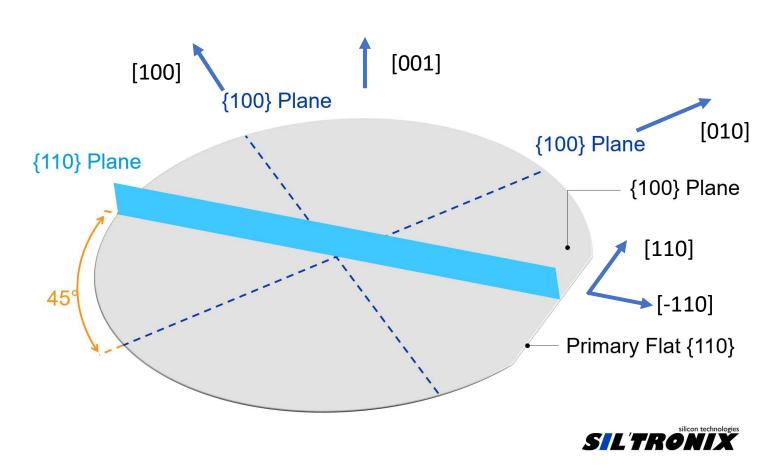
常用的硅晶圆有(100)(或者叫做(001))、(110)、(111)三种表面



用不同晶面截断的硅晶圆理化性质有差异: 例如功函数;刻蚀、单晶生长等性质

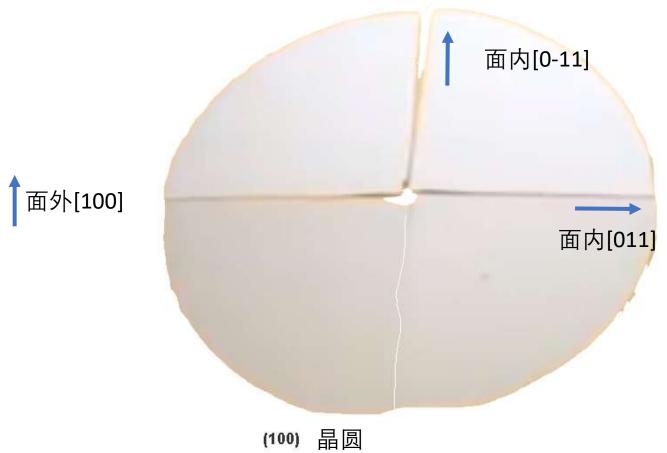
硅晶圆的晶向

常见的Si(001)晶圆的结构, 注意平边



硅的解理面(cleavage plane)

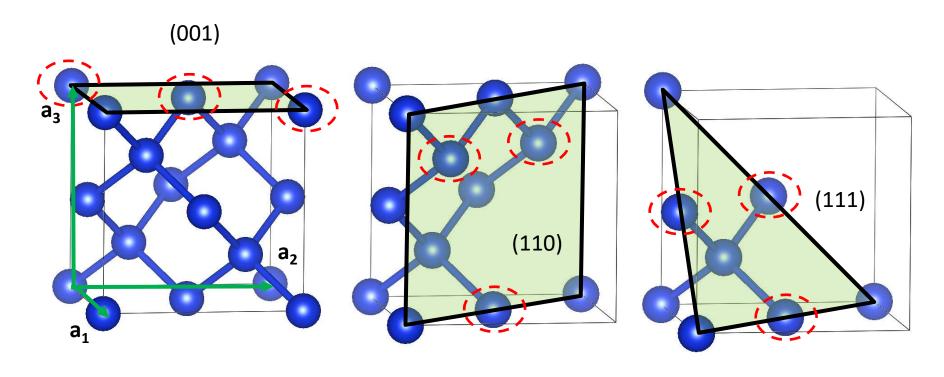
解理: 容易沿着某方向破裂



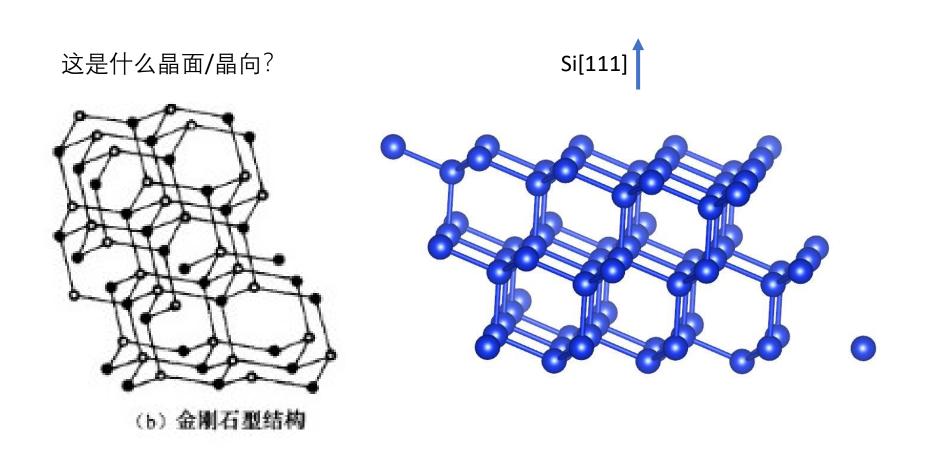
University wafer company

晶面上的化学键密度

比较不同晶面的化学键面密度,可得知{110}面容易解理

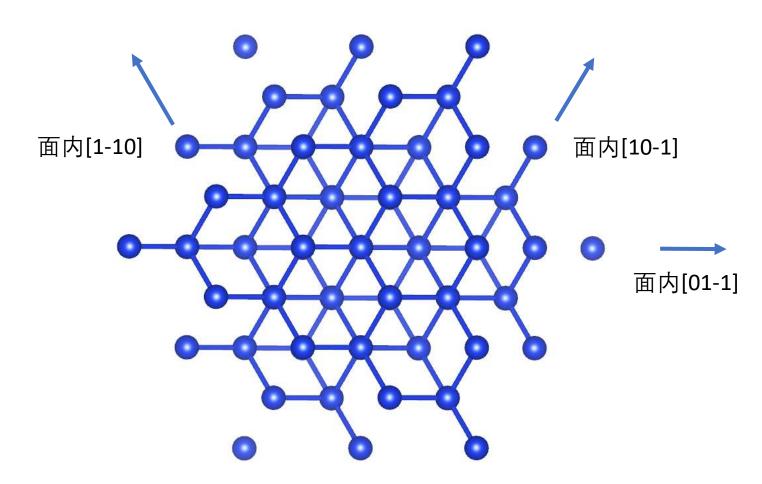


半导体晶体结构的不同画法

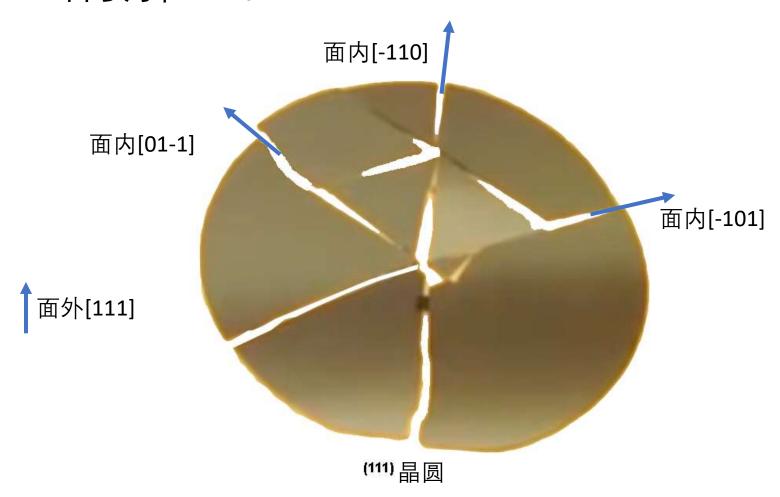


半导体晶体结构的不同画法

Si(111) 俯视: 六方对称性

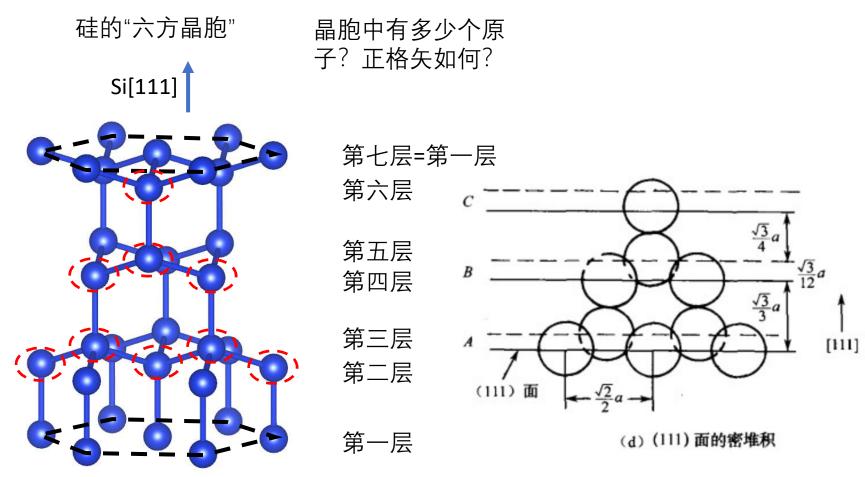


硅的解理面



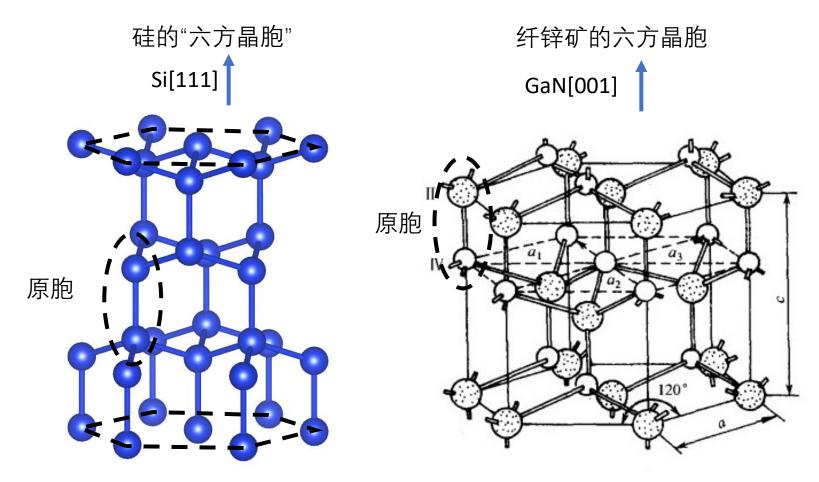
University wafer company

半导体晶体结构的不同画法



为什么硅不是六方晶体?

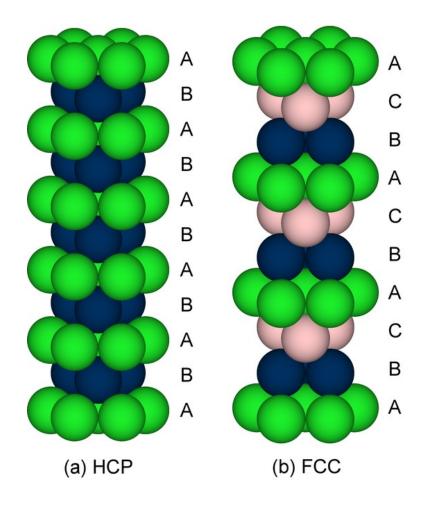
金刚石[111]和纤锌矿比较



两者层数、c/a、原子排布均有显著差异 原胞晶格的差异到底在哪里?

金刚石[111]和纤锌矿原胞比较

hcp晶格: A-B两种方式不 断叠层

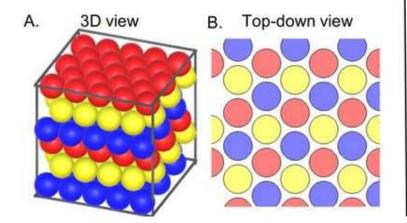


fcc晶格: A-B-C三种方式 不断叠层

金刚石[111]和纤锌矿原胞比较

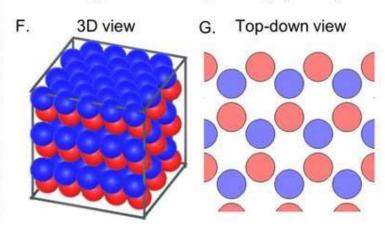
fcc晶格: A-B-C三种方式不断叠层

Face-centred cubic lattice (FCC)



hcp晶格: A-B两种方式不断叠层

Hexagonal close packing (HCP)

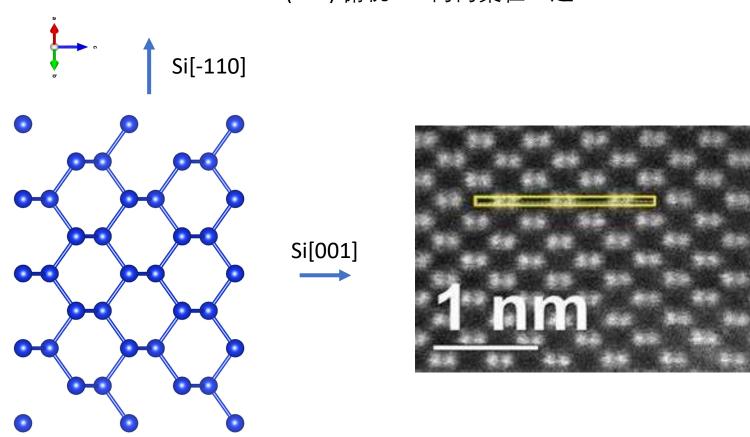


金刚石[111]和纤锌矿原胞比较

fcc晶格叠层和立方晶格的构造 В

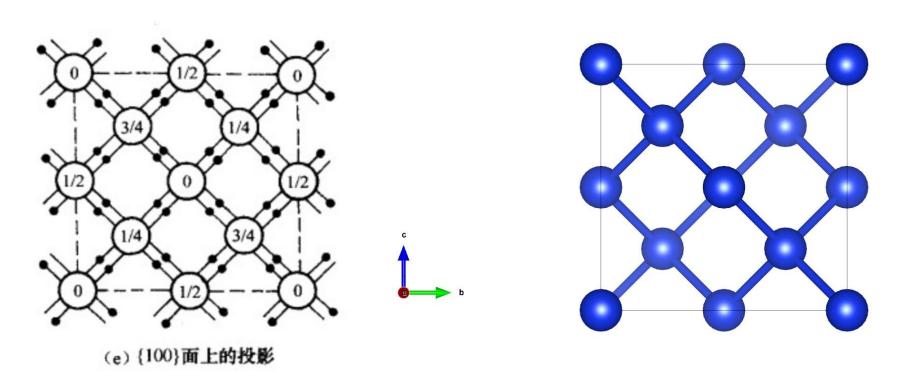
半导体晶体结构的不同画法

Si(110) 俯视: Si两两聚在一起



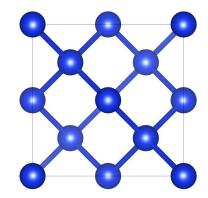
半导体晶体结构的不同画法

Si(100) 俯视



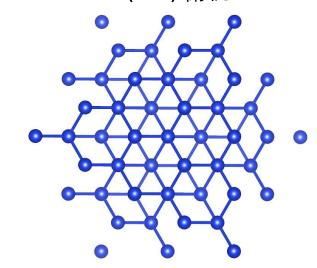
Si晶体在不同方向上的投影

Si(100) 俯视



Si(110) 俯视

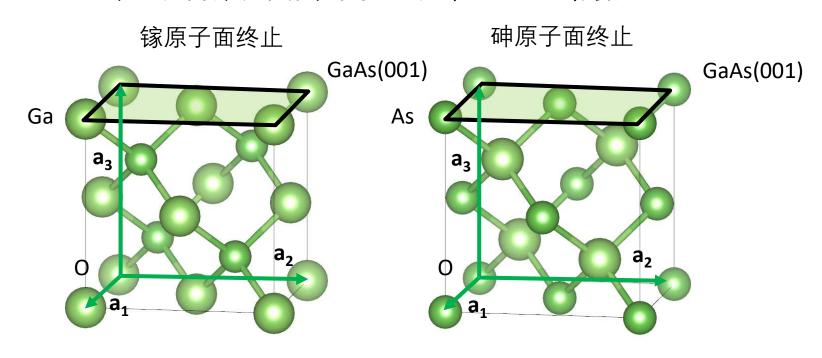
Si(111) 俯视



立方闪锌矿的常见晶面

大部分和金刚石型相同

但立方闪锌矿中有某原子面终止(termination)的概念



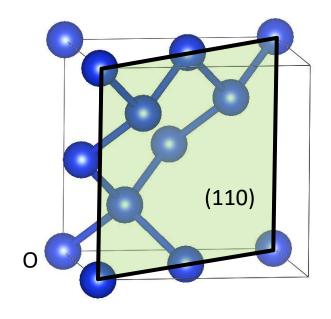
晶体表面终止在哪种元素上同样对其性质有影响

可标注为:某原子面终止的GaAs(001)

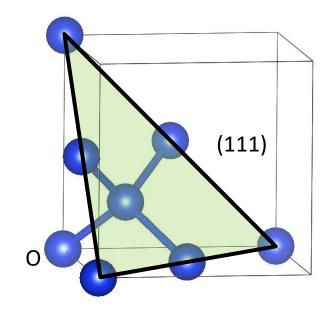
立方闪锌矿的常见晶面

大部分和金刚石型相同

(110)和(111)是否有某原子面终止的概念?



1、4、5层: 混合了Ga和As



1、3、5层:可为纯的Ga或As

立方闪锌矿的常见晶面

在{111}晶面中也有Ga-和As-面终止的情况

可标注为:某原子面终止的GaAs(111)

也可以将本来等价的(111)和(-1-1-1)晶面分别指III族和V族元素

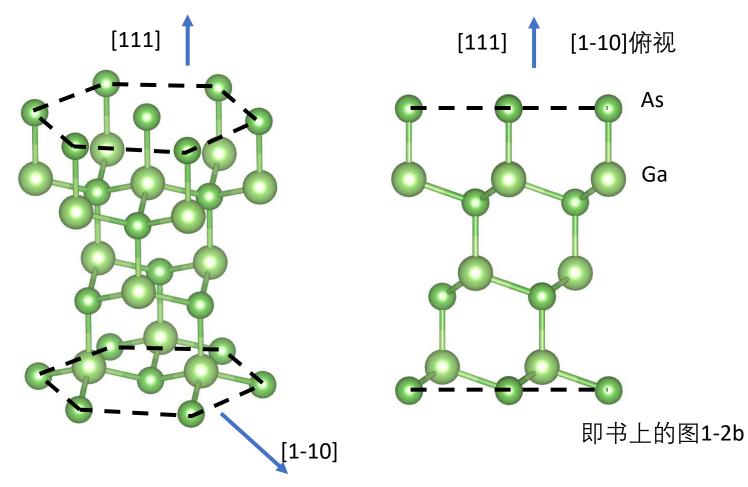
GaAs(111) 镓原子面终止

GaAs(-1-1-1)

砷原子面终止

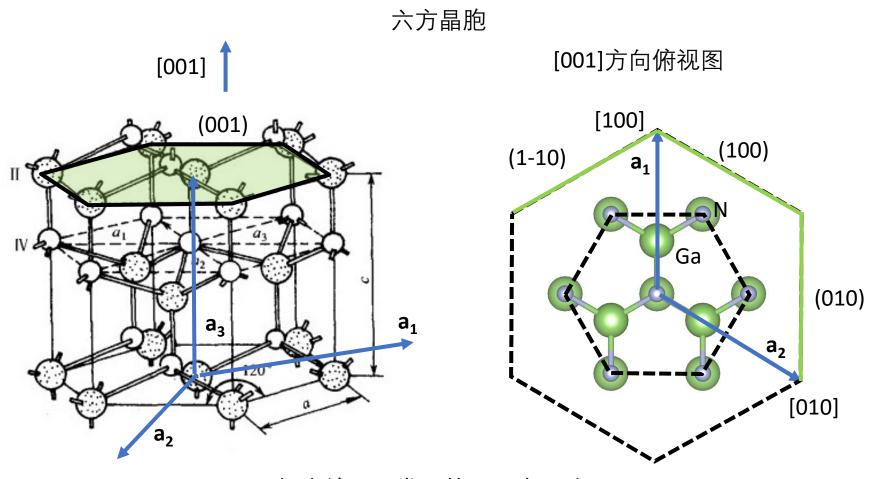
立方闪锌矿晶体的极性

GaAs的"六方晶胞"



每层间距? As/Ga不对称是否会导致电偶极矩?

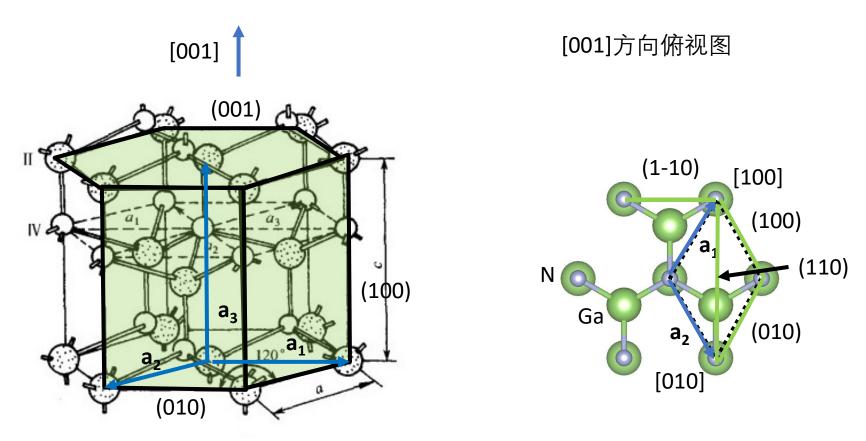
六方晶格晶面的表示方法



但这并不是常见的晶面表示法

六方晶格晶面的表示方法

平行四边形晶胞

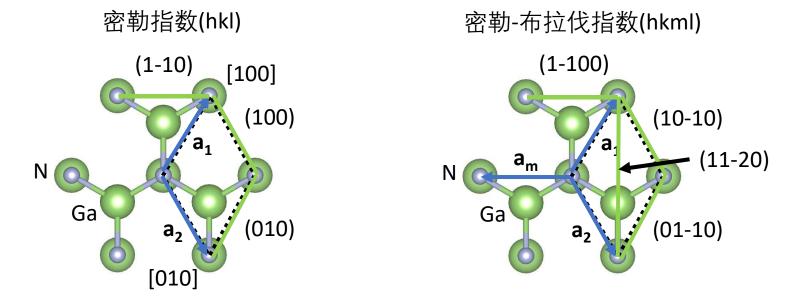


六方晶格中, (100)和[100]并不垂直

六方晶格晶面的表示方法

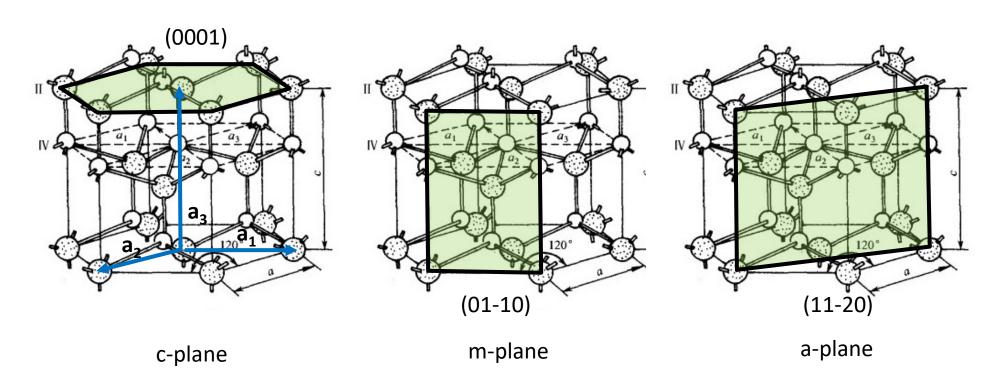
平行四边形晶胞

[001]方向俯视图



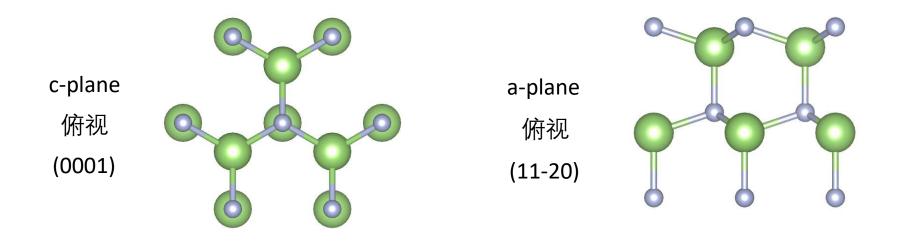
平行四边形晶胞+密勒-布拉伐指数(hkml)是六方晶格的一种惯用表示法 在很多文献里常见

六方晶格的常见晶面



{0001}、{01-10}、{11-20}各有几个等价的晶面?分别是?

GaN晶体在不同方向上的投影



m-plane 俯视 (01-10)

这些晶体结构都是真实存在的吗?

观测晶体结构的实验手段

- 直接观察手段
 - 透射电子显微镜(TEM, transmission electron microscopy)
 - 扫描透射电子显微镜(STEM, scanning transmission electron microscopy),分辨率更高
- 间接精确测量手段
 - X射线衍射(XRD, X-ray diffraction)

常见的电子显微技术

- 透射电镜技术
 - 透射电子显微镜(TEM, transmission electron microscopy)
 - 扫描透射电子显微镜(STEM, scanning transmission electron microscopy),分辨率更高
- 扫描电子显微镜(SEM, scanning electron microscopy),分辨率为纳米,适合观察器件
- 扫描隧道显微镜(STM, scanning tunneling microscopy),用于观察表面形貌和表面能带结构

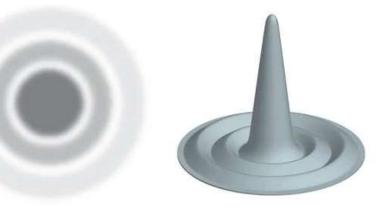
显微镜的分辨率

点光源经过透镜成像后由于衍射 形成艾里斑

Figure 1 - Resolution Limit Imposed by Wave Nature of Light

Point Source Point Source (a) (b) Objective Objective Aperture Airy Disk Image Plane P1 → P 10 Units 18 Units **Imaged Spot Size Imaged Spot Size** (Low NA) (High NA) Nikon, microscopyu.com

艾里斑形状和强度分布

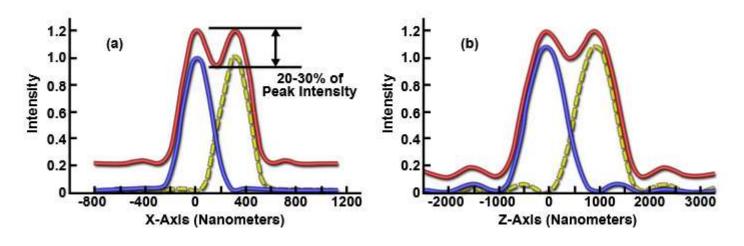


Leica, leicamicrosystems.com

显微镜的分辨率

两个点光源如果相隔太近,低于分辨率,就无法区分两者的艾里斑

Figure 2 - The Rayleigh Criterion for Lateral Axial Resolution



Nikon, microscopyu.com

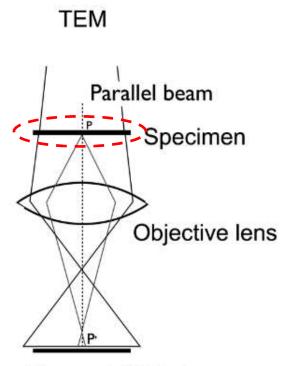
$$R = 0.61\lambda/NA$$

称为瑞利分辨率, λ为波长, NA~1称为数值孔径, 和显微镜光路有关 降低波长, 分辨率更好(可见光400-700 nm)

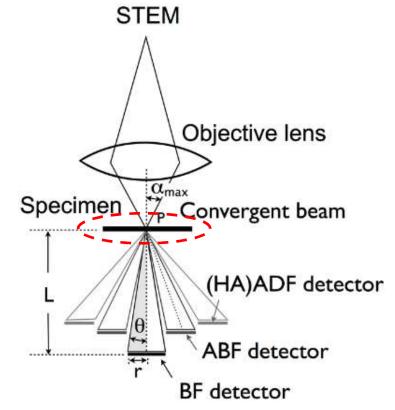
100 keV能量电子,由 $E=\frac{p^2}{2m}$, $p=\hbar k$,k=2π/λ,波长为0.012 nm,远低于晶格常数

透射电子显微镜

利用高能电子的短波长,制备原子尺度分辨的显微镜



Energy filter and CCD detector



S. Wolf et al., Nat Methods 11, 423 (2014).

TEM: 未完全聚焦的电子束照射到样品上 STEM: 聚焦成一点的电子束照射到样品上

TEM和STEM的区别

• TEM

- 原理和光学显微镜类似
- 光学透镜可以非常精密, 电磁透镜尚未能达到
- TEM分辨率小于理论极限

STEM

• S (扫描), 指电子束在样品上扫描

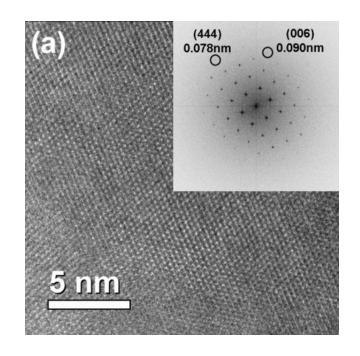
• 分辨率能超过原子级别

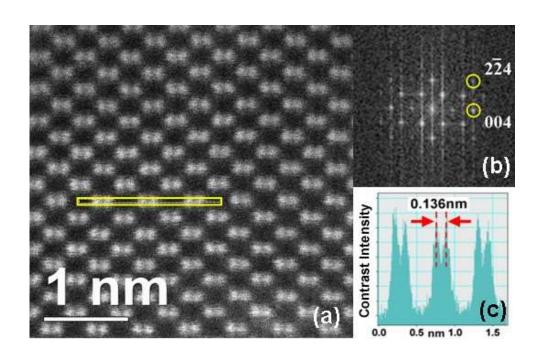


TEM和STEM显微图像对比

TEM图像(及其傅里叶变换)

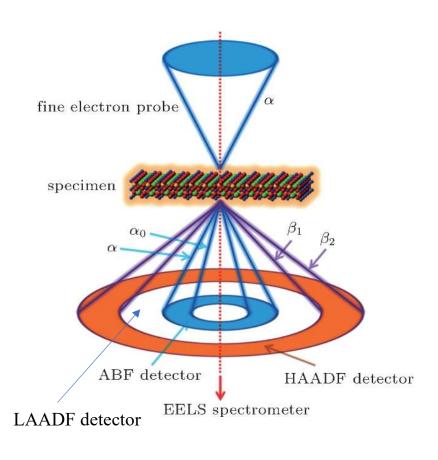
STEM图像(及其傅里叶变换)





I. M. Ross et al., J. Phys. Conference Series 371, 012013 (2012).

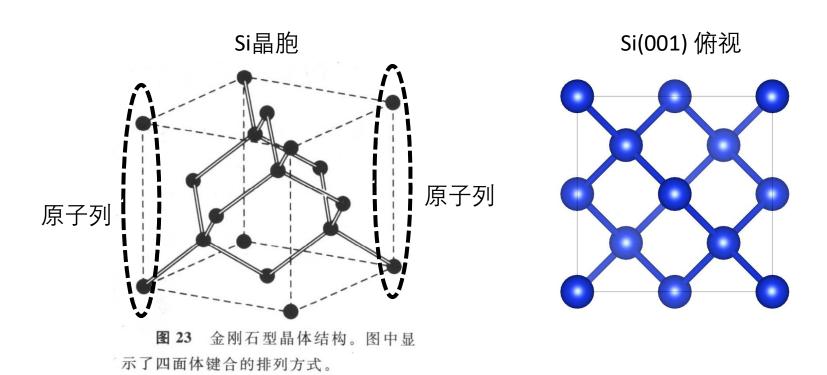
STEM的不同探测器



- HAADF (高角边缘暗场)
 - 原子位置,原子序数越 大信号越强(Z⁴)
- LAADF(低角边缘暗场)
 - 原子位置和应变场
- ABF (边缘明场)
 - 原子位置,原子序数越小信号越强
- EELS (电子能量损失谱)
 - 分辨原子种类

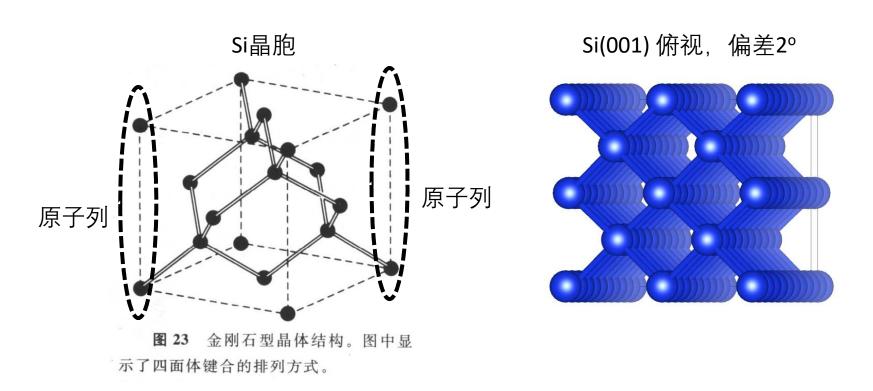
TEM和STEM中的原子列

TEM和STEM都需要俯视排列整齐的原子列(column)才能成像



TEM和STEM中的原子列

如果斜着看就无法成像



透射电子显微技术中, 将电子束调得和某晶向平行非常重要